



Чипы памяти на основе технологии PRAM от Samsung (Phase-change Random Access Memory – технология памяти на основе фазового перехода, не путайте с Parameter RAM для Mac) будут доступны уже в июне. Новый тип памяти объединяет в себе преимущества флеш-памяти NAND и NOR: высокоскоростной произвольный доступ и долговечность хранения данных. Особенность технологии в том, что перед записью новых данных не требуется предварительная очистка занятых ранее областей. Благодаря этому скорость работы PRAM будет в 30 раз превышать производительность современной флеш-памяти NOR и NAND, а прослужат PRAM-чипы по циклам перезаписи в 10 раз дольше.

Технологические особенности нового типа памяти таковы, что на нынешний момент технология обладает наибольшей архитектурной масштабируемостью, и, теоретически, в итоге разработок можно будет достичь скоростей работы обычной RAM памяти, но вдобавок получить энергонезависимое хранение. Новая разработка, имеется в виду практическая реализация уже совсем не новых технологий, может дать мощный импульс отрасли энергонезависимой памяти. Ожидается, что чипы PRAM-памяти будут дешевле и миниатюрнее современных NAND-чипов (с учетом даже объемов современных Flash накопителей, недавно Samsung представила 32Гб NAND-чип с использованием техпроцесса 40 нм).

В настоящее время технология представлена в виде прототипов чипа PRAM-памяти емкостью 512 Мб, а начало массового производства более емких чипов намечено на июнь.